

МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

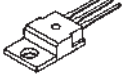
HARRIS является мировым лидером в производстве **Power MOSFET**.

Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

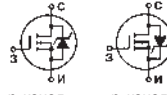
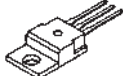
Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов.

Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

Power MOSFET, серия IRF

											
п-канал		р-канал									
Максим. значения											
V_{GS}, B		I_{DS}, A		$R_{DS(on)}, \Omega$		TO-204		TO-220AB		TO-247	
										DIP-4	
п-канал											
100	0,4	3,2									IRFD122
	0,8	0,8									IRFD112
	1,3	0,3									IRFD120
	5,6	0,54				IRF510					
	9,2	0,27	IRF120			IRF520					
	14,0	0,16				IRF530					
	28,0	0,077	IRF140			IRF540					
200	40,0	0,055	IRF150						IRFP150		
	0,45	2,4									IRFD212
	0,80	0,8									IRFD220
	3,3	1,5				IRF610					
	5,0	0,8	IRF220			IRF620					
	9,0	0,4	IRF230			IRF630					
	18,0	0,18	IRF240			IRF640					
400	33,0	0,085	IRF250						IRFP250		
	0,4	3,6									IRFD310
	2,0	3,6				IRF710					
	3,3	1,8	IRF320								
	5,5	1,0	IRF330			IRF730					
	10,0	0,55	IRF340			IRF740					
	16,0	0,3	IRF350					IRFP350			
500	23,0	0,2	IRF360					IRFP360			
	2,5	3,0	IRF420			IRF820					
	4,5	1,5	IRF430			IRF830					
	8,0	0,85	IRF440								
	14,0	0,4	IRF450					IRFP450			
	20,0	0,27	IRF460					IRFP460			
	4,3	3,5						IRFPG40			
р-канал											
100	1,0	0,6									IRFD9120
	3,0	1,2				IRF9510					
	6,0	0,6				IRF9520					
	12,0	0,3	IRF9130			IRF9530					
	19,0	0,2	IRF9140			IRF9540		IRFP9140			
200	3,5	1,5				IRF9620					
	6,5	0,8	IRF9230			IRF9630					
	11,0	0,5	IRF9240			IRF9640					

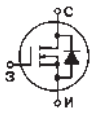
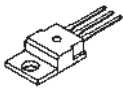
Mega FET серия

			
п-канал		р-канал	
Максим. значения			
V_{GS}, B	I_{DS}, A	$R_{DS(on)}, \Omega$	TO-220AB
п-канал			
50	14	0,1	RFP14N05
	25	0,047	RFP25N05
	50	0,22	RFP50N05
100	22	0,080	RFP22N10
	40	0,040	RFP40N10
р-канал			
50	8	0,300	RFP8P05
	15	0,150	RFP15P05
	30	0,065	RFP30P05
п-канал, управление логическим уровнем			
50	4	0,800	RFP4N05L
	14	0,100	RFP14N05L
	25	0,047	RFP25N05L
	50	0,022	RFP50N05L
100	2	1,050	RFP2N10L
	7	0,300	RFP7N10LE
	12	0,200	RFP12N10L
200	2	3,500	RFP2N20L
	8	0,500	RFP8N20L
р-канал, управление логическим уровнем			
30	10	0,225	RFP10P03L

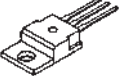


Более подробную информацию можно получить по адресу www.semi.harris.com или заказав литературу непосредственно у **HARRIS**. Бланк для заказа литературы приведен в каталоге.

п-канальные MOSFET, серия BUZ

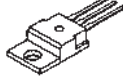
		Максимальные значения			Максимальные значения				
		V_{GS}, B	I_{DS}, A	$R_{DS(on)}, \Omega$	V_{GS}, B	I_{DS}, A	$R_{DS(on)}, \Omega$		
		50	14,0	0,1	BUZ71	200	9,5	0,4	BUZ32
			30,0	0,04	BUZ11	400	3,0	1,8	BUZ76
		100	9,0	0,25	BUZ72A		5,5	1,0	BUZ60
			19,0	0,1	BUZ21	500	4,0	2,0	BUZ42
		200	5,8	0,6	BUZ73A	1000	4,3	3,5	RFP4N100

Улучшенные Power MOSFET

			
		TO-220AB	
Максим. значения			
V_{GS}, B	$I_{DS(огр.)}, A$	$R_{DS(on)}, \Omega$	
80	1	0,75	RLP1N08LE
	5,5	0,12	RLP5N08LE

RLP1N08LE, RLP5N08LE

Имеют встроенную схему, ограничивающую max значения I_{DS} на уровне 1 А и 5,5 А соответственно. Встроенный стабилизатор защищает от статического электричества до 2 кВ.

			
		TO-220AB	
Максим. значения			
V_{GS}, B	$I_{DS(огр.)}, A$	$R_{DS(on)}, \Omega$	
55	1	0,75	RLP1N06CLE

RLP1N06CLE

Имеют схему ограничения I_{DS} , защелку по напряжению (уровень 60÷70 В), встроенный стабилизатор для защиты от статического электричества до 2 кВ.